

結合 스롯트 線路의 새로운 解析

(A New Analysis of a Coupled Slotlines)

林 永 錫*, 裴 正 二**

(Young Suk Lim and Chung Yi Bae)

要 約

本論文에서는結合 스롯트線路의特性을解析할수있는간단하며새로운式을유도하였다.이는S.B.Cohn의 단일 스롯트線路의解析法을基礎로하여,偶모우드와奇모우드에서의總어드미턴스式을종래의解析法과다르게접근하여Knorr와Kuchler의計算值와比較,잘一致함을볼수있었다.

Abstract

A new equation, which enables us to calculate the characteristics of coupled slot-lines on a dielectric substrate, is derived. Their calculations are based on the single slot-line analysis of S.B. Cohn, but each equation of total admittance in the even mode and the odd mode is derived by a different approach.

The results agree with Knorr and Kuchler's data.

I. 序 論

形 空腔 모델로 놓을 수 있다.

스롯트線路의特性解析은 1969年 S.B. Cohn^[1]에 의하여 처음試圖되었다. 그結果, 여파기, 방향성 결합기등의 超高周波回路의構成에 스롯트線路를利用할 수 있었다^[2].結合 스롯트線路의解析은 1975年 Knorr 와 Kuchler^[3]에 의하여 이루어졌다. 이들은 Itoh 와 Mittra의^[4] 단일 스롯트線路의混成 모우드 解析法을結合 스롯트線路에까지 확장시켜서,結合 스롯트線路의特性를 구할 수 있었다. 本論文에서는, S.B. Cohn이 단일 스롯트線路의解析에 이용하였던導波管모델을結合 스롯트線路에 적용하여解析하였다.

II. 解析方法

1. 矩形 空腔모델

그림 1(a)와 같은結合 스롯트線路는,傳途波長(λ_g)이 $\lambda_g = 2a$ 인 周波數(f_0)에서는 그림 1(b)와 같이矩

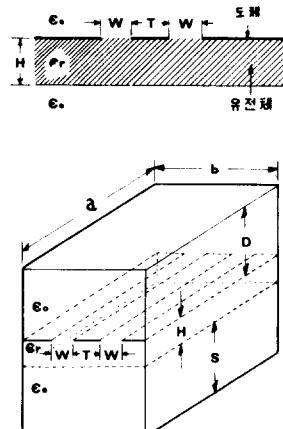


그림 1.結合 스롯트線路와 空腔의 모델

Fig. 1. Coupled slot line and its cavity model.

이때周波數 f_0 는 그림 1(b)의矩形空腔의 공진周波數에 해당되므로,周波數 f_0 인波에 대하여는矩形空腔의總어드미턴스 Y 가 0이되어야 한다. 따라서,

*非會員, **正會員, 서울大學校 工科大學 電子工學科
(Dept. of Elec. Eng., Seoul National Univ.)

接受日字 : 1982年 3月 24日

$$Y(a, f_0) = 0 \quad (1)$$

이라 둘 수 있다. 그러므로, Y 의 表現式을 알게 되면 (1)式으로 부터 周波數 f_0 인 波에 대한 $Y(a, f_0) = 0$ 를 만족시키는 a , 즉 스롯트線路에서의 傳送波長 λg 를 구할 수 있으며, 더 나아가 임피던스 特性까지 알 수 있다.^[1]

따라서, 다음은 그림 1(b)의 矩形空腔 모델의 奇, 偶모우드에서의 總어드미턴스를 구하는 方法을 세시한 것이다.

스롯트線路를 따라 進行하는 x 方向의 電界 E_x 는 다음과 같은 級數로 둘 수 있다.

$$E_x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n f_n(x) \quad (2)$$

여기서 a_n 을 矩形空腔의 n 次 모우드의 電界의 세기로 定義하면, n 次 모우드의 等價단자전압 V_n 은 n 次 모우드의 電界 E_{xn} 의 實效值로 定義된다.^[5] 또한, 展開函數 $f_n(x)$ 를 直交性을 갖도록 취하면, 각 모우드는 獨立的이 되어, 矩形空腔의 등가회로를 그림 2와 같이 나타낼 수 있다.

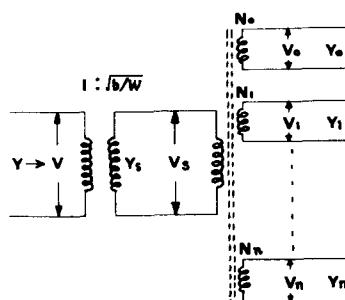


그림 2. 矩形空腔 모델의 等價回路

Fig. 2. Equivalent circuit of rectangular cavity model.

위의 等價回路에서 總어드미턴스는 다음과 같이 된다.

$$Y = \frac{b}{w} \cdot Y_s = \frac{b}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{V_n}{V_s} \right)^2 \cdot Y_n \quad (3)$$

여기서, V_s 는 電界 E_x 의 實效值로 導波管모델의 端子電圧이며, V 는 스롯트線路의 端子電圧이다.

上記의 式(3)에서 Y_n 은 n 次 모우드의 어드미턴스로서, n 次 모우드의 波動어드미턴스 y_n 과는 다음과 같은 관계가 있다.^{[1], [6]}

$$Y_n = \frac{I_n}{V_n} = \frac{a}{2b} y_n = \frac{a}{2b} \frac{H_{zn}}{E_{xn}} \quad (4)$$

式(3)으로 부터 總어드미턴스 Y 는, (V_n / V_s) 와 Y_n 을 구하면 알 수 있다.

Y_n 을 구하는 方法은, 奇, 偶모우드에 따라서 S.B. Cohn^[1]의 方法과 대동소이하므로 그 과정을 부록에 실었다.

다음으로 (V_n / V_s) 를 구하는 과정은 다음과 같다.

結合 스롯트線路上에서의 電界分布를 근사적으로 그림 3과 같이 놓을 수 있다.

偶모우드의 경우 電界分布는 그림 3(a)와 같으므로 展開函數 $f_n(x)$ 는

$$f_n(x) = \cos \frac{2n\pi}{b} x$$

가 되므로 式(2)에 代入하면,

$$E_x = \sum_{n=0}^{\infty} a_{ne} \cos \frac{2n\pi}{b} x \quad (5)$$

가 된다. 스롯트線路의 導波管모델의 端子전압 V_s 는 定義에 의하여

$$V_{se} = \sqrt{\frac{1}{b} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} E^2 dx} = \sqrt{\frac{2w}{b}} \quad (6)$$

가 되고, n 次모우드의 端子전압 V_n 은

$$\begin{aligned} V_{ne} &= \frac{2\sqrt{2}}{n\pi} \cos \frac{n\pi(T+w)}{b} \cdot \sin \frac{n\pi w}{b} : n=1, 2, \dots \\ V_{ne} &= \frac{2w}{b} : n=0 \end{aligned} \quad (7)$$

가 된다.

以上의 (5), (6) 式들로 부터

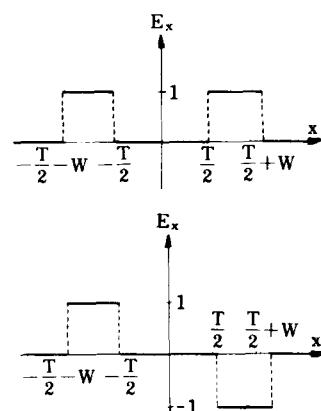


그림 3. 스롯트上의 電界分布

Fig. 3. Assumed field distribution on slot line.

$$\left(\frac{V_{se}}{V_{se}}\right)^2 = \begin{cases} \frac{2w}{b} & : n=0 \\ \frac{4w}{b} \left(\frac{b}{n\pi w}\right)^2 \cos^2 \frac{n\pi(T+W)}{b} \sin^2 \frac{n\pi w}{b} & : n=1, 2, \dots \end{cases} \quad (8)$$

로 표시된다.

奇모우드의 경우 電界分布는 그림 3 (b) 와 같으므로 電界는 다음 式으로 표시된다.

$$E_x = \sum_{n=0}^{\infty} a_{no} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{b} \quad (9)$$

偶모우드의 경우에서와 같이 端子 전압을 각각 구하면,

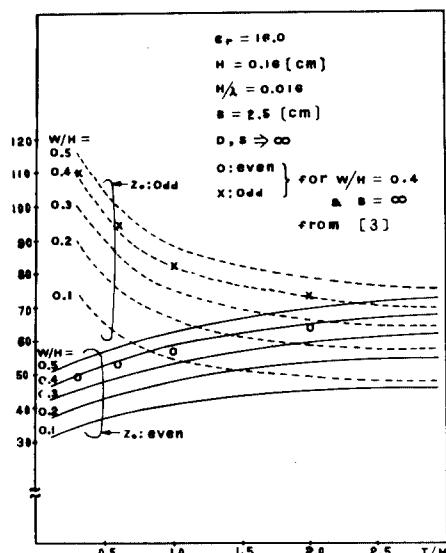
$$V_{so} = V_{se} = \sqrt{\frac{2w}{b}}$$

$$V_{no} = \frac{4\sqrt{2}}{(2n-1)\pi} \cdot \sin \left(\frac{2n-1}{2} \cdot \frac{\pi w}{2} \right) \sin \frac{(2n-1)\pi(W+T)}{2b} \quad : n=1, 2, \dots$$

$$V_{no} = 0 \quad : n=0$$

가 되므로

$$\left(\frac{V_{so}}{V_{so}}\right)^2 = \begin{cases} 0 & : n=0 \\ \frac{4w}{b} \left(\frac{b}{w(n-\frac{1}{2}\pi)} \right)^2 \sin^2 \frac{(n-\frac{1}{2})\pi w}{b} & : n=1, 2, \dots \end{cases}$$



$$\sin^2 \frac{(n-\frac{1}{2})\pi(T+W)}{b} : n=1, 2, \dots \quad (10)$$

가 된다.

本論文에서는 設計目的에 맞는 여러가지 변형된 형태의結合 스롯트線路의 特性을 계산할 수 있게 하기 위하여, D, S, b와 같은 변수들을 도입하였을 때이다.

앞에서 구한 式(7), (10)를 式(3)에 대입하여 구한 總어드미턴스는 다음과 같다.

i) 偶모우드의 경우

$$Y_{even} = 2Y_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 4 \left(\frac{b}{w(n-\frac{1}{2}\pi)} \right)^2 \cos^2 \frac{n\pi w(T+W)}{b} \sin^2 \frac{n\pi w}{b} Y_n \quad (11)$$

ii) 奇모우드의 경우

$$Y_{odd} = \sum_{n=1}^{\infty} 4 \left(\frac{b}{w(n-\frac{1}{2}\pi)} \right)^2 \sin^2 \frac{(n-\frac{1}{2})\pi w}{b} \sin^2 \frac{(n-\frac{1}{2})\pi(T+W)}{b} Y_n \quad (12)$$

위의 式(11), (12)에 부록의 Y_n 式을 代入하면 완전한 式이 되어 [1]의 方法으로 奇, 偶모우드에서의結合 스롯트線路의 特性을 구할 수 있다.

다음의 그림 4는, 比誘電率 ϵ_r 이 16.0인 유전체를 갖는結合 스롯트線路의 特性을 計算하여 図示한 것이다. 이 計算에서는 Knorr와 Kuchler^[3]의 데이터와 비교하기 위하여, D와 S를 매우 큰 값으로 취하여 스

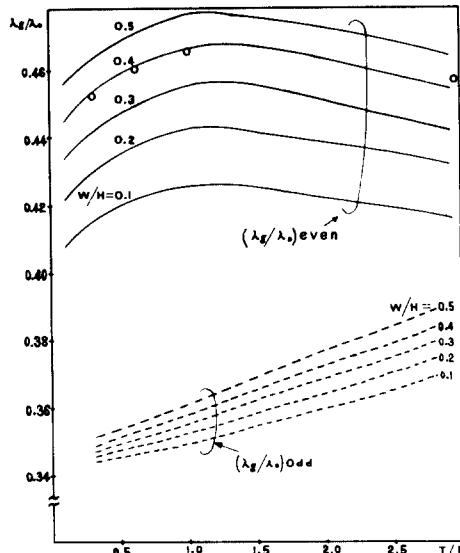


그림 4. 結合ス롯트 線路의 特性

Fig. 4. Characteristics of coupled slot line.

스롯트上의 電界分布에 영향을 주지 않도록 하였으며, b는 S. B. Cohn^[1]의 계산과 실험을 근거로 역시, 스롯트上의 電界分布에 영향을 미치지 않도록 $b=2.5$ [cm]의 값을 취하였다.

III. 檢討 및 結論

結合 스롯트線路를 矩形空腔으로 모델화하여 구한線路의 임피던스와 傳送波長의 特性은, Knorr와 Kuchler가 무척 부합한 計算을 하여 圖示한 데이터를 標本하여 比較한 결과 잘一致함을 確認하였다.

本論文의 附錄에 提示한 Y_n 의 誘導式으로서 D, S, b 등의 변수들을 設計目的에 符合되게 취하면, 各種 여과기, 方向性 결합기등의 設計에 유용한 데이터를 얻을 수 있다.

謝 意

本論文을 위하여 極めて 指導해 주신 서울大學校 工科大學 電子工學科 崔桂根教授님께 感謝드립니다.

附 錄

n次 모우드의 어드미턴스 (Y_n)

本文의 式(4)로 부터

$$Y_n = \frac{a}{2b} \cdot \frac{H_{zn}}{E_{xn}} \quad (A1)$$

임을 알았다. 그런데, 스롯트上의 電磁界 分布는 TE 모우드도 아니고, TM모우드도 아닌 hybrid 모우드이므로, 이를 TE, TM으로 분리하면 式(A1)은

$$Y_n = \frac{a}{2b} \left(\frac{H_{zn, TE} + H_{zn, TM}}{E_{xn, TE} + E_{xn, TM}} \right) \quad (A2)$$

로 둘 수 있게 되는데, 그 결과로

$$Y_n = \frac{a}{2b} \cdot \frac{\frac{H_{zn, TM}}{E_{xn, TM}} + \frac{H_{zn, TE}}{E_{xn, TE}} \cdot \frac{E_{xn, TE}}{E_{xn, TM}}}{1 + \frac{E_{xn, TE}}{E_{xn, TM}}} \quad (A3)$$

$$= \frac{a}{2b} \cdot \frac{Y_{n, TM} + K \cdot Y_{n, TE}}{1 + K}$$

$$\text{단, } K = \frac{E_{xn, TE}}{E_{xn, TM}} = \left(\frac{b}{2na}\right)^2$$

가 될을 알 수 있다.

따라서, Y_n 은 n次 모우드의 TE, TM 波動 어드미턴스 $Y_{n, TM}, Y_{n, TE}$ 를 구하면 알 수 있게 된다.

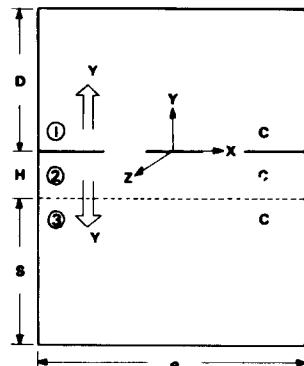


그림 A1. 矩形空腔 모델

Fig. A1. Rectangular cavity model.

$Y_{n, TM}$ 과 $Y_{n, TE}$ 를 구하기 위하여 矩形空腔 모델을 그린 것이 그림(A1)이다.

스롯트上에서의 波動 어드미턴스 Y_n 은

$$Y_n = _1 Y_n + _2 Y_n \quad (A4)$$

로 표시할 수 있다.

①, ②, ③의 각 영역에서의 波動어드미턴스는

$$\begin{cases} Y_{n, TM1} = j \frac{\omega \epsilon_0 \epsilon_i}{\gamma_{in}} = j \frac{k_0 \epsilon_i}{\gamma_{in} \eta} \\ Y_{n, TE1} = -j \frac{\gamma_{in}}{\omega \mu} = -j \frac{\gamma_{in}}{k_0 \eta} \end{cases}$$

단 : $i=1, 2, 3$

γ_{in} 은 y 방향 전파상수

ϵ_i 는 i영역의 비유전율

이므로

$$_1 Y_{n, TM} = Y_{n, TM1} \coth \gamma_{in} D$$

$$_2 Y_{n, TM} = Y_{n, TM2} \cdot \frac{Y_{n, TM3} \coth \gamma_{in} S + Y_{n, TM2} \tanh \gamma_{in} H}{Y_{n, TM2} + Y_{n, TM3} \coth \gamma_{in} S \tanh \gamma_{in} H}$$

$$_1 Y_{n, TE} = Y_{n, TE1} \coth \gamma_{in} D$$

$$_2 Y_{n, TE} = Y_{n, TE2} \cdot \frac{Y_{n, TE3} \coth \gamma_{in} S + Y_{n, TE2} \tanh \gamma_{in} H}{Y_{n, TE2} + Y_{n, TE3} \coth \gamma_{in} S \tanh \gamma_{in} H}$$

(A5)

가 됨을 쉽게 알 수 있다.

式(A5)를 式(A4)에 代入하여, 그 결과를 式(A3)에 代入하면 구하고자 하는 n次 모우드의 어드미턴스 Y_n 을 얻게 된다.

즉,

$$Y_n = \frac{a}{2b} \cdot \frac{Y_{nTM_1} \coth \gamma_1 D + Y_{nTM_2} \cdot \frac{Y_{nTM_2} \tanh \gamma_{1n} H + Y_{nTM_3} \coth \gamma_{1n} S}{Y_{nTM_2} + Y_{nTM_3} \coth \gamma_{1n} S \tanh \gamma_{2n} H}}{1 + (\frac{b}{2na})^2}$$

$$\left(\frac{b}{2na} \right)^2 \left[Y_{nTE_1} \coth \gamma_{1n} D + Y_{nTE_2} \cdot \frac{Y_{nTE_2} \coth \gamma_{1n} S + Y_{nTE_3} \tanh \gamma_{2n} H}{Y_{nTE_2} + Y_{nTE_3} \coth \gamma_{1n} S \tanh \gamma_{2n} H} \right] \quad (A6)$$

이다.

여기서 구한 Y_n 은 偶모우드의 경우의 값이고 奇모우드인 경우에는, 本文의 式(9)의 電界分布로 인하여, 式(A5)의 Y_n 에서 n 을 $(n - \frac{1}{2})$ 로 치환하여 구한다.

式(A6)에 ①, ②, ③ 각 영역에서의 波動어드미턴스를 代入하여 정리하면 다음과 같다.

$$Y_0 = -j \frac{a}{2b\eta} \left\{ V \coth \frac{2\pi}{\lambda_0} VD - U \tan \left[\frac{2\pi UH}{\lambda_0} - \tan^{-1} \left(\frac{V}{U} \coth \frac{2\pi VS}{\lambda_0} \right) \right] \right\} \quad : n=0$$

$$Y_n = j \frac{a}{2n\eta \lambda_0 \left[1 + (b/2na)^2 \right]} \cdot \left[\frac{R_n}{X_{1n}} + \frac{\varepsilon_r P_n - (\lambda_0/2a)^2 X_{2n}^2 Q_n^2}{X_{2n}} \right] \quad : n=1, 2, 3, \dots$$

단, $\begin{cases} V = \sqrt{(\lambda_0/2a)^2 - 1} \\ U = \sqrt{\varepsilon_r - (\lambda_0/2a)^2} \\ X_{1n} = \sqrt{1 + (b/n\lambda_0)^2 V^2} \\ X_{2n} = \sqrt{1 - (b/n\lambda_0)^2 U^2} \end{cases}$

$$\left| \begin{array}{l} R_n = \left\{ 1 - (\lambda_0/2a)^2 X_{1n}^2 \right\} \coth \frac{2n\pi}{b} \times_{1n} D \\ P_n = \frac{(X_{2n}/X_{1n}\varepsilon_r) \coth \frac{2n\pi}{b} X_{1n} S + \tanh \frac{2n\pi}{b} X_{2n} H}{1 + (X_{2n}/X_{1n}\varepsilon_r) \coth \frac{2n\pi}{b} X_{1n} S \tanh \frac{2n\pi}{b} X_{2n} H} \\ Q_n = \frac{\coth \frac{2n\pi}{b} X_{1n} S + (X_{2n}/X_{1n}) \tanh \frac{2n\pi}{b} X_{2n} H}{(X_{2n}/X_{1n}) + \coth \frac{2n\pi}{b} X_{1n} S \tanh \frac{2n\pi}{b} X_{2n} H} \end{array} \right.$$

参考文献

- [1] S.B. Cohn "Slotline on a dielectric substrate," *IEEE Trans. MTT*, vol. MTT-17, no. 10, pp. 768-778, Oct. 1969.
- [2] E.A. Mariani and J.P. Agrios, "Slotline filters and couplers," *IEEE Trans. MTT*, vol. MTT-18, no.12, pp. 1089-1095, Dec. 1970.
- [3] J.B. Knorr and K.D. Kuchler, "Analysis of coupled slots and coplanar strips on dielectric substrate," *IEEE Trans. MTT*, vol. MTT-23, no.7, pp. 541-548, July 1975.
- [4] T. Ittoh and R. Mittra, "Dispersion characteristics of slotlines," *Electron. Letter*, vol. 7, pp. 364-365, July 1971.
- [5] N. Marcuvitz, *Waveguide Handbook*, M.I.T. Rad. Lab. Ser., vol. 10, pp.7, New York; McGraw Hill, 1957.
- [6] E.C. Jordan and K. G. Balmain, *Electromagnetic Waves and Radiating Systems*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall Inc., pp. 262-264, 1968.